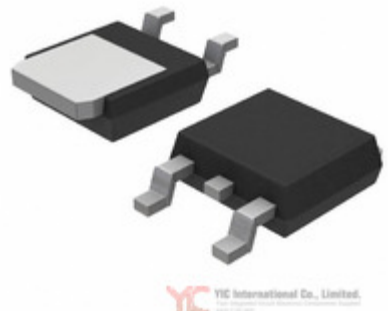

	<h2 style="color: red;">NVD5802NT4G-TB01</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: NVD5802NT4G-TB01
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 101A DPAK
	Datenblätter:  NVD5802NT4G-TB01.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	NVD5802NT4G-TB01
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 101A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.4 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 93.75W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5300pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 16.4A (Ta), 101A (Tc) 2.5W (Ta),
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.4A (Ta), 101A (Tc)

NVD5802NT4G-TB01 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVD5802NT4G-TB01-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVD5802NT4G-TB01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NVD5802NT4G-TB01 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NVD5802NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 16.4A DPAK</p>	 <p>NVD5490NLT4G-VF01 ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17A DPAK</p>	 <p>NVD5805NT4G VB NVD5805NT4G VB</p>	 <p>NVD5803N ON NVD5803N ON</p>
 <p>NVD5490NLT4G ON NVD5490NLT4G ON</p>	 <p>NVD5805NT4G-VF01 ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 51A DPAK</p>	 <p>NVD5802NT4G ON ON TO-252</p>	 <p>NVD5803NT4G ON NVD5803NT4G ON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVD5802NT4G-TB01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVD5802NT4G-TB01 Datenblatt	NVD5802NT4G-TB01-Datenblätter	NVD5802NT4G-TB01 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVD5802NT4G-TB01
NVD5802NT4G-TB01 Electronic	NVD5802NT4G-TB01-Komponenten	NVD5802NT4G-TB01-Verteiler	NVD5802NT4G-TB01-Bild	NVD5802NT4G-TB01-Teil
NVD5802NT4G-TB01 Preis	NVD5802NT4G-TB01 Hersteller	NVD5802NT4G-TB01 Bild	NVD5802NT4G-TB01 Aktie	NVD5802NT4G-TB01 Inventar
NVD5802NT4G-TB01 Neu	NVD5802NT4G-TB01 Original	NVD5802NT4G-TB01 garantiert	NVD5802NT4G-TB01 RFQ	NVD5802NT4G-TB01 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited